

Power MOSFET

P6B52HP2

525V 6A

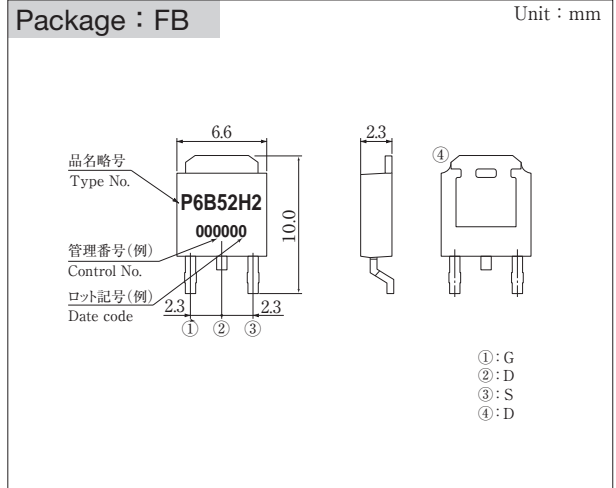
特長

- 面実装タイプ
- 高耐圧
- 低ノイズ
- 低オン抵抗

Feature

- SMD
- High Voltage
- Low Noise
- Low R_{ON}

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元 Web サイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

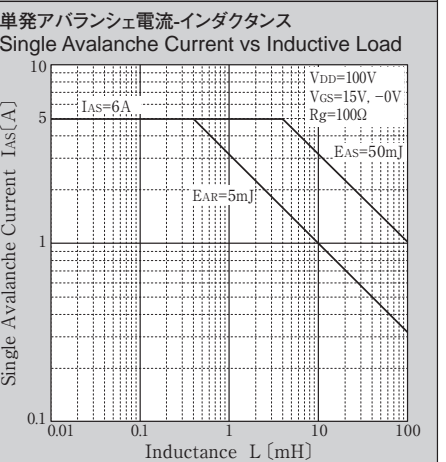
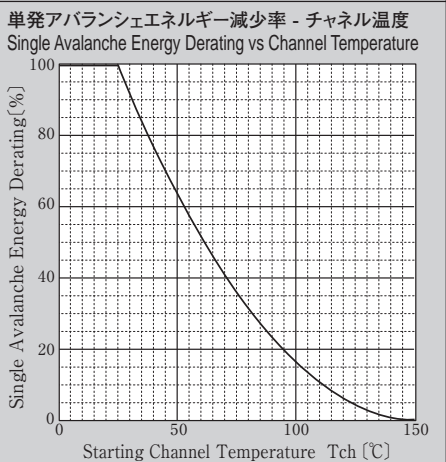
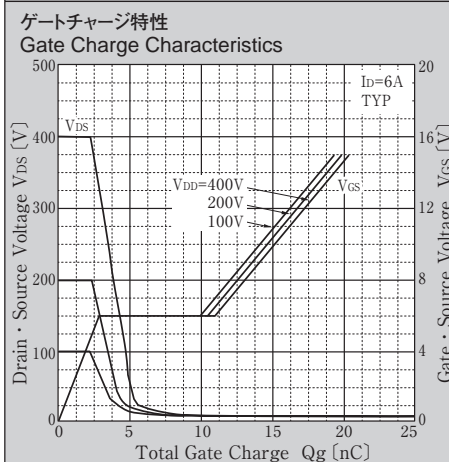
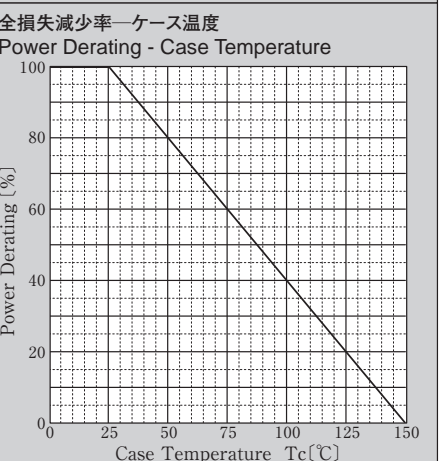
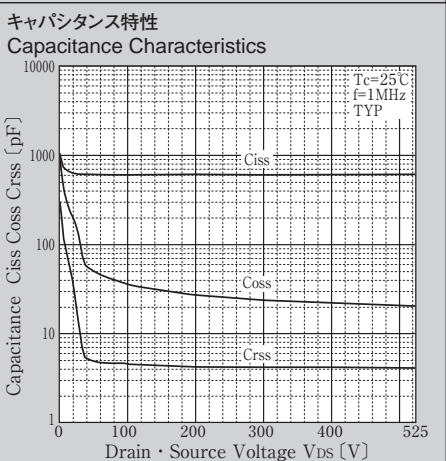
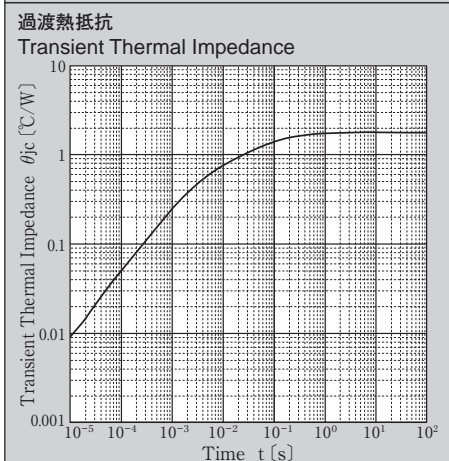
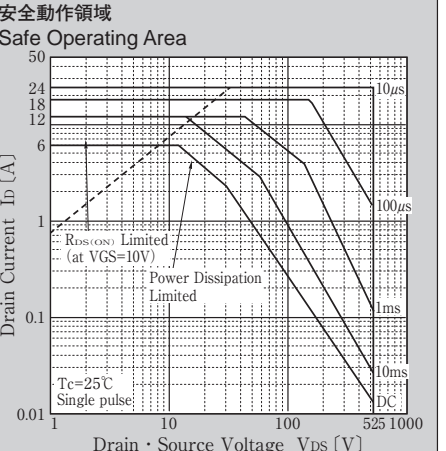
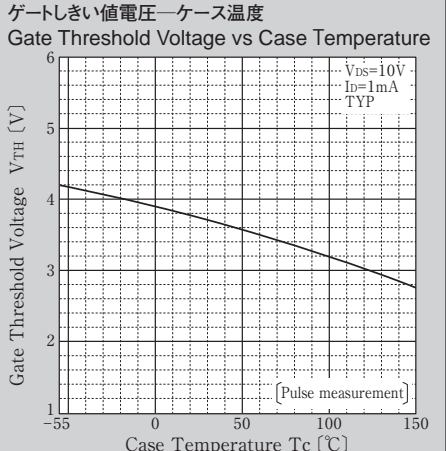
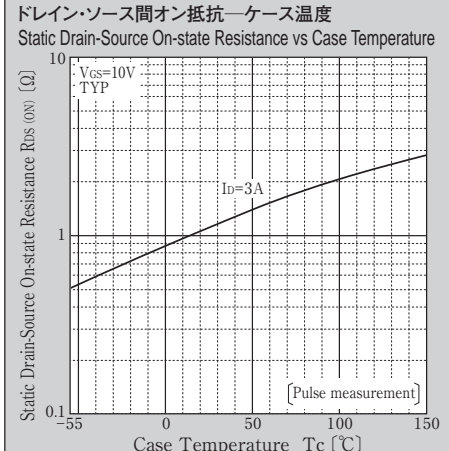
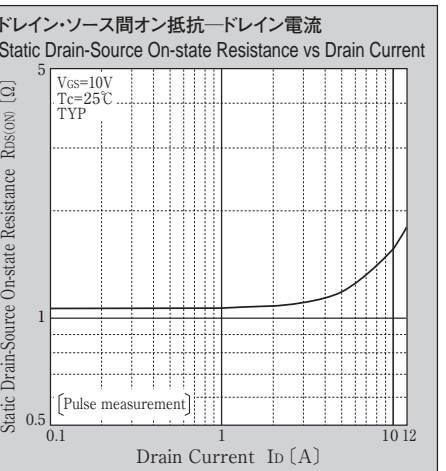
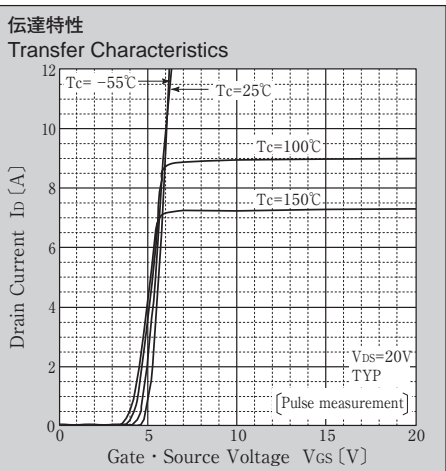
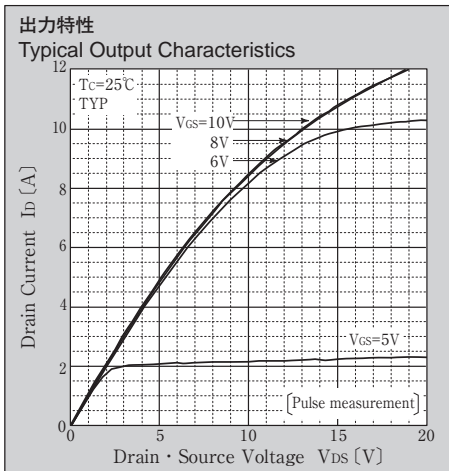
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$ /unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
チャネル温度 Channel Temperature	Tch		150	
ドレイン・ソース間電圧 Drain-Source Voltage	V_{DSS}		525	V
ゲート・ソース間電圧 Drain-Source Voltage	V_{GSS}		±30	
ドレイン電流 (直流) Continuous Drain Current (DC)	I_D		6	A
ドレイン電流 (ピーク) Continuous Drain Current (Peak)	I_{DP}	パルス幅 10 μs , duty = 1/100 Pulse width 10 μs , duty = 1/100	24	
ソース電流 (直流) Continuous Source Current (DC)	I_S		6	W
全損失 Total Power Dissipation	P_T		70	
繰り返しアバランシェ電流 Repetitive Avalanche Current	I_{AR}	Starting Tch = 25°C, Tch ≤ 150°C	6	A
単発アバランシェエネルギー Single Avalanche Energy	E_{AS}	Starting Tch = 25°C, Tch ≤ 150°C	50	mJ
繰り返しアバランシェエネルギー Repetitive Avalanche Energy	E_{AR}	Starting Tch = 25°C, Tch ≤ 150°C	5	
ドレイン・ソース間ダイオード di/dt 耐量 Drain-Source Diode di/dt Strength	di/dt	$I_S = 6\text{A}$, $T_c = 25^\circ\text{C}$	350	A/ μs

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$ /unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			MIN	TYP	MAX	
ドレイン・ソース間降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)DSS}$	$I_D = 1\text{mA}$, $V_{GS} = 0\text{V}$	525	—	—	V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS} = 525\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$	—	—	100	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 25\text{V}$, $V_{DS} = 0\text{V}$	—	—	±10	μA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	gfs	$I_D = 3\text{A}$, $V_{DS} = 10\text{V}$	2	6	—	S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	$R_{(DS)ON}$	$I_D = 3\text{A}$, $V_{GS} = 10\text{V}$	—	1.1	1.35	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V_{TH}	$I_D = 1\text{mA}$, $V_{DS} = 10\text{V}$	3.0	3.75	4.5	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V_{SD}	$I_S = 3\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$	—	—	1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	—	—	1.78	°C/W
ゲート全電荷量 Total Gate Charge	Q_g	$V_{DD} = 400\text{V}$, $V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 6\text{A}$	—	15	—	nC
入力容量 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS} = 50\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$	—	520	—	pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}		—	5.5	—	
出力容量 Output Capacitance	C_{oss}		—	58	—	
ターンオン遅延時間 Turn-on delay time	td(on)	$I_D = 3\text{A}$, $R_L = 50\Omega$, $V_{DD} = 150\text{V}$, $R_g = 50\Omega$, $V_{GS(+)} = 10\text{V}$, $V_{GS(-)} = 0\text{V}$	—	15	—	ns
上昇時間 Rise time	tr		—	20	—	
ターンオフ遅延時間 Turn-off delay time	td(off)		—	40	—	
下降時間 Fall time	tf		—	25	—	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.